

(TSRI) U18-114C 下線晶片資料

請注意：

- 1.此資料包含:下線晶片與不下線晶片。
- 2.下線晶片資料按 10%部分負擔、新進教師晶片、優良晶片、教育性晶片排列。
- 3.申請編號中，序號英文字母代表：A:10%部分負擔，E:教育性晶片，N:新進教師晶片，I:優良晶片。序號之尾端字母代表：a:使用 Cell-based Design Kit，m:使用 Multi-option-MEMS(TSRI MEMS 後製程)，M:整合晶片。
- 4.可否下線準則依序：有無回覆委員建議(未回覆完整視同未回覆,不予下線)、審查評等結果(優先順序為 A>B>C，D:視面積使用情況下線，F:不予下線)、教授加總積點、是否為科技部計畫所需、可擺放的剩餘面積等。
- 5.若委員建議修改佈局，依規定不可比原佈局增加長寬邊的長度，違者則不予採用已修改之佈局檔案。

下線晶片資料(申請編號/專題名稱(課程名稱)/包裝形式/晶片面積)：

申請編號: U18-114C-A0001m
專題名稱(中文): 二氧化氮感測器
專題名稱(英文): NO2 sensor
包裝形式: Package:N/A + DieSort:18EA
晶片面積: 0.540*0.532 mm²

申請編號: U18-114C-A0002m
專題名稱(中文): CMOS-MEMS 電容式三合一軸之差分模態磁力感測計
專題名稱(英文): Differential Proof-Mass CMOS-MEMS Capacitive Three-Axis Magnetometer
包裝形式: Package:40 S/B:8Pcs + DieSort:10EA
晶片面積: 2.682*2.534 mm²

申請編號: U18-114C-A0003a
專題名稱(中文): 用於感測 IC 中供電和數據傳輸的 RFID 通訊 IC 設計
專題名稱(英文): The design of an RFID communication IC for powering and data transmission in a sensing IC
包裝形式: Package:N/A + DieSort:18EA
晶片面積: 1.184*1.011 mm²

申請編號: U18-114C-A0004

專題名稱(中文): 用於雙向晶片間通訊的 28Gb/s 收發器
專題名稱(英文): A 28 Gb/s Transceiver for Bi-Directional Die-to-Die Communication
包裝形式: Package:N/A + DieSort:18EA
晶片面積: 6.606*2.918 mm²

申請編號: U18-114C-A0005m
專題名稱(中文): CMOS-MEMS 電容式多軸慣性感測計
專題名稱(英文): CMOS-MEMS Capacitive Multi-Axis Inertial Sensor
包裝形式: Package:48 S/B:8Pcs + DieSort:10EA
晶片面積: 3.234*3.385 mm²

申請編號: U18-114C-A0006
專題名稱(中文): 藉由 T WELL 降低漏電流的三軸磁電晶體
專題名稱(英文): Triaxial Magnetic Bipolar Transistor (MBT) Using a T-Well to Suppress Leakage Current
包裝形式: Package:N/A + DieSort:18EA
晶片面積: 1.105*1.105 mm²

申請編號: U18-114C-A0007m
專題名稱(中文): 溫度補償多模態調諧質量阻尼共振器之物理不可複製功能
專題名稱(英文): Temperature-Compensated Multi-Modal Tuned Mass Damper Resonators for Physical Unclonable Function
包裝形式: Package:N/A + DieSort:18EA
晶片面積: 2.200*2.200 mm²

申請編號: U18-114C-A0009m
專題名稱(中文): 基於微機電非線性彈簧軟化共振開關之多模態變化含溫度補償
專題名稱(英文): Multi-state of MEMS Nonlinear Spring-Softening Resonant Structures With Temperature Compensate
包裝形式: Package:N/A + DieSort:18EA
晶片面積: 2.802*2.314 mm²

申請編號: U18-114C-A0011m
專題名稱(中文): 推拉式微機電共振開關
專題名稱(英文): push pull resoswitch
包裝形式: Package:N/A + DieSort:18EA
晶片面積: 2.388*2.104 mm²

申請編號: U18-114C-R0002a
專題名稱(中文): 低功耗之非侵入式複數介電係數感測系統
專題名稱(英文): Lower-Power Non-invasive Complex Dielectric Constant Sensing System

包裝形式: Package:N/A + DieSort:18EA
晶片面積: 1.393*1.183 mm²

申請編號: U18-114C-E0001

專題名稱(中文): 類比積體電路佈局(null)

專題名稱(英文): 加減法電路系統晶片(Addition and subtraction circuit system chip)

包裝形式: Package:40 S/B:2Pcs

追加顆數:0Pcs + DieSort:16EA

晶片面積: 1.500*1.500 mm²

申請編號: U18-114C-E0002

專題名稱(中文): 類比積體電路佈局(null)

專題名稱(英文): 基本數位邏輯電路(Basic digital logic circuits)

包裝形式: Package:40 S/B:2Pcs

追加顆數:0Pcs + DieSort:16EA

晶片面積: 1.500*1.500 mm²

申請編號: U18-114C-E0003

專題名稱(中文): 類比積體電路佈局(null)

專題名稱(英文): 比較器萬用型控制器(Comparator Universal Controller)

包裝形式: Package:24 S/B:2Pcs

追加顆數:0Pcs + DieSort:16EA

晶片面積: 1.500*1.500 mm²

申請編號: U18-114C-E0004

專題名稱(中文): 類比積體電路佈局(null)

專題名稱(英文): 改良型音樂盒控制器(Improved music box controller)

包裝形式: Package:40 S/B:2Pcs

追加顆數:0Pcs + DieSort:16EA

晶片面積: 1.500*1.500 mm²

申請編號: U18-114C-E0005

專題名稱(中文): 類比積體電路佈局(null)

專題名稱(英文): 改良型增強版與雨水感測器(Improved and enhanced version with rain sensor)

包裝形式: Package:40 S/B:2Pcs

追加顆數:0Pcs + DieSort:16EA

晶片面積: 1.500*1.500 mm²

申請編號: U18-114C-E0006

專題名稱(中文): CMOS 射頻電路設計專題(Special topics in cmos RF circuit design)

專題名稱(英文): 8*8 陣列乘法器(8x8 array multiplier)

包裝形式: Package:40 S/B:2Pcs

追加顆數: 0Pcs + DieSort:16EA

晶片面積: 1.353*1.468 mm²

申請編號: U18-114C-E0007

專題名稱(中文): 資料轉換積體電路(null)

專題名稱(英文): 動態縮放輸入範圍三角積分類比數位轉換器(Dynamic Zoom Delta-Sigma ADC)

包裝形式: Package:自費包裝

48 S/B: 3Pcs + DieSort:15EA

晶片面積: 1.497*1.497 mm²

申請編號: U18-114C-E0009

專題名稱(中文): CMOS 射頻電路設計專題(null)

專題名稱(英文): Dadda Tree 演算法 八乘八乘法器(Dadda Tree 8*8 Multiplier)

包裝形式: Package:40 S/B:2Pcs

追加顆數: 0Pcs + DieSort:16EA

晶片面積: 1.353*1.468 mm²

申請編號: U18-114C-E0010

專題名稱(中文): CMOS 射頻電路設計專題(SPECIAL TOPICS IN CMOS RF CIRCUIT DESIGN)

專題名稱(英文): 類比低壓差線性穩壓器(Analog Low Dropout Regulator)

包裝形式: Package:18 S/B:2Pcs

追加顆數: 0Pcs + DieSort:16EA

晶片面積: 0.925*0.810 mm²

申請編號: U18-114C-E0011

專題名稱(中文): CMOS 射頻電路設計專題(null)

專題名稱(英文): 運用 4*4 Wallace 乘法器組成 8*8 Vedic 乘法器(A 8x8 Vedic multiplier composed in 4x4 wallance tree multiplier)

包裝形式: Package:40 S/B:2Pcs

追加顆數: 0Pcs + DieSort:16EA

晶片面積: 1.353*1.468 mm²

申請編號: U18-114C-E0013

專題名稱(中文): CMOS 射頻電路設計專題(null)

專題名稱(英文): 八乘八 VEDIC 乘法器(8*8 VEDIC MULTIPLIER)

包裝形式: Package:40 S/B:2Pcs

追加顆數: 0Pcs + DieSort:16EA

晶片面積: 1.353*1.468 mm²

申請編號: U18-114C-E0014
專題名稱(中文): CMOS 射頻電路設計專題(null)
專題名稱(英文): 兩級運算放大器(Two stage OP Amp)
包裝形式: Package:18 S/B:2Pcs
追加顆數:0Pcs + DieSort:16EA
晶片面積: 0.894*0.779 mm²

申請編號: U18-114C-E0015
專題名稱(中文): CMOS 射頻電路設計專題(null)
專題名稱(英文): 9 位元高速同步上下數器(A 9 Bits High-speed Synchronous Up-down Counter)
包裝形式: Package:40 S/B:2Pcs
追加顆數:0Pcs + DieSort:16EA
晶片面積: 1.353*1.468 mm²

申請編號: U18-114C-E0016
專題名稱(中文): VLSI 設計導論(null)
專題名稱(英文): 8 乘 8 有號數乘法器(8x8 signed multiplier)
包裝形式: Package:40 S/B:2Pcs
追加顆數:0Pcs + DieSort:16EA
晶片面積: 1.469*1.469 mm²

申請編號: U18-114C-E0018
專題名稱(中文): 類比積體電路實驗(AIC LAB)
專題名稱(英文): Low Dropout Regulator 全晶片設計與驗證(Low Dropout Regulator full-custom IC Design and Verification)
包裝形式: Package:18 S/B:2Pcs
追加顆數:0Pcs + DieSort:16EA
晶片面積: 1.094*0.873 mm²

申請編號: U18-114C-E0019
專題名稱(中文): CMOS 射頻電路設計專題(null)
專題名稱(英文): 基於五位元 TSPC 架構 D 型觸發器之高速同步 32 除頻器(A High-Speed Synchronous Divide-by-32 Frequency Divider Based on a 5-bit TSPC D Flip-Flop Architecture)
包裝形式: Package:40 S/B:2Pcs
追加顆數:0Pcs + DieSort:16EA
晶片面積: 1.353*1.468 mm²

申請編號: U18-114C-E0020
專題名稱(中文): 類比積體電路實驗(AIC LAB)

專題名稱(英文): Low-Dropout Regulator 全晶片設計與驗證(Low Dropout Regulator full-custom IC Design and Verification.)

包裝形式: Package:18 S/B:2Pcs

追加顆數:0Pcs + DieSort:16EA

晶片面積: 0.725*0.883 mm²

申請編號: U18-114C-E0021

專題名稱(中文): CMOS 射頻電路設計專題(null)

專題名稱(英文): 8bitsCSA 乘法器(8bitsCSA multiplier)

包裝形式: Package:40 S/B:2Pcs

追加顆數:0Pcs + DieSort:16EA

晶片面積: 1.387*1.494 mm²

申請編號: U18-114C-E0022

專題名稱(中文): 類比積體電路實驗(null)

專題名稱(英文): Low Dropout Regulator 全晶片設計與驗證(Low Dropout Regulator full-custom IC Design and Verification.)

包裝形式: Package:18 S/B:2Pcs

追加顆數:0Pcs + DieSort:16EA

晶片面積: 1.049*0.747 mm²

申請編號: U18-114C-E0023

專題名稱(中文): 類比積體電路佈局(null)

專題名稱(英文): 具高低溫補償之帶隙參考電壓電路(Bandgap reference voltage circuit with high and low temperature compensation)

包裝形式: Package:18 S/B:2Pcs

追加顆數:0Pcs + DieSort:16EA

晶片面積: 0.988*0.923 mm²

申請編號: U18-114C-E0024

專題名稱(中文): 類比積體電路實驗(null)

專題名稱(英文): Low-Dropout Regulator 全晶片設計與驗證(Low Dropout Regulator full-custom IC Design and Verification.)

包裝形式: Package:18 S/B:2Pcs

追加顆數:0Pcs + DieSort:16EA

晶片面積: 0.887*0.748 mm²

申請編號: U18-114C-E0025

專題名稱(中文): 類比積體電路實驗(Analog Integrated Circuits LAB)

專題名稱(英文): Low Dropout Regulator 全晶片設計與驗證(Low Dropout Regulator full-custom IC Design and Verification)

包裝形式: Package:18 S/B:2Pcs

追加顆數:0Pcs + DieSort:16EA

晶片面積: 0.753*0.655 mm²

申請編號: U18-114C-E0027

專題名稱(中文): 類比積體電路實驗(null)

專題名稱(英文): Low-Dropout Regulator 全晶片設計與驗證(Full-Chip Design and Verification of Low-Dropout Regulator)

包裝形式: Package:18 S/B:2Pcs

追加顆數:0Pcs + DieSort:16EA

晶片面積: 0.697*0.681 mm²

申請編號: U18-114C-E0029

專題名稱(中文): 生醫晶片電路設計導論(null)

專題名稱(英文): 電流模式遲滯降壓轉換器(A Current Mode Hysteretic Buck Converter)

包裝形式: Package:18 S/B:2Pcs

追加顆數:0Pcs + DieSort:16EA

晶片面積: 1.311*0.676 mm²

申請編號: U18-114C-E0030m

專題名稱(中文): 半導體製作與量測(null)

專題名稱(英文): 場發射三極體作為充放電元件(Field Emission Triode as a Charge-Discharge Component)

包裝形式: Package:N/A + DieSort:18EA

晶片面積: 1.479*1.483 mm²

申請編號: U18-114C-E0031

專題名稱(中文): 類比積體電路佈局(null)

專題名稱(英文): 74190 進階版控制與選擇紅綠燈訊號產生器(74190 Advanced version control and selection of traffic light signal generator)

包裝形式: Package:40 S/B:2Pcs

追加顆數:0Pcs + DieSort:16EA

晶片面積: 1.500*1.500 mm²

申請編號: U18-114C-E0032

專題名稱(中文): 射頻積體電路設計(null)

專題名稱(英文): 無參考訊號源之 2Gbps 資料時脈恢復電路(Crystal less 2gbps CDR)

包裝形式: Package:N/A + DieSort:18EA

晶片面積: 0.653*0.497 mm²

申請編號: U18-114C-E0033

專題名稱(中文): 高等電源管理晶片設計與實習(null)

專題名稱(英文): 具電流緩衝補償之低壓差線性穩壓器含帶差參考電路(A Low-Dropout Linear Regulator With Current Buffer Compensation And Bandgap Reference)

包裝形式: Package:28 S/B:2Pcs
追加顆數:0Pcs + DieSort:16EA
晶片面積: 0.938*0.938 mm²

申請編號: U18-114C-E0034
專題名稱(中文): 資料轉換積體電路(null)
專題名稱(英文): 十位元每秒四千萬次取樣的連續漸進式類比數位轉換器(A 10-bit 40-MS/s SAR ADC)
包裝形式: Package:N/A + DieSort:18EA
晶片面積: 1.499*1.497 mm²

申請編號: U18-114C-E0035m
專題名稱(中文): 微感測器與微致動器(Micro Sensors and Actuators)
專題名稱(英文): 用於致動的 CMOS 電熱式橫向微致動器(CMOS electrothermal lateral micromovers for actuation)
包裝形式: Package:40 S/B:2Pcs
追加顆數:0Pcs + DieSort:16EA
晶片面積: 1.500*1.500 mm²

申請編號: U18-114C-E0036m
專題名稱(中文): 微感測器與微致動器(Micro Sensors and Actuators)
專題名稱(英文): 雙階樑結構微機電致動器(Double stepped beam structure MEMS actuator)
包裝形式: Package:40 S/B:2Pcs
追加顆數:0Pcs + DieSort:16EA
晶片面積: 1.500*1.500 mm²

申請編號: U18-114C-E0037a
專題名稱(中文): 積體電路系統測試專題(null)
專題名稱(英文): LED 控制電路(LED Display Controller)
包裝形式: Package:40 S/B:2Pcs
追加顆數:0Pcs + DieSort:16EA
晶片面積: 1.493*1.493 mm²

申請編號: U18-114C-E0038
專題名稱(中文): CMOS 射頻電路設計專題(null)
專題名稱(英文): 8x8 Booth 乘法器(8x8 Booth multiplier)
包裝形式: Package:40 S/B:2Pcs
追加顆數:0Pcs + DieSort:16EA
晶片面積: 1.353*1.468 mm²

申請編號: U18-114C-E0039m

專題名稱(中文): 半導體製作與量測(null)

專題名稱(英文): 垂直式場發射三極體(Vertical Field Emission Triode)

包裝形式: Package:N/A + DieSort:18EA

晶片面積: 1.498*1.498 mm²

申請編號: U18-114C-E0041a

專題名稱(中文): 積體電路系統測試專題(null)

專題名稱(英文): 霍夫曼編碼(huffman coding)

包裝形式: Package:40 S/B:2Pcs

追加顆數: 0Pcs + DieSort:16EA

晶片面積: 1.313*1.313 mm²

申請編號: U18-114C-E0042a

專題名稱(中文): 高可靠度系統之設計、測試與應用(DESIGN, TEST, AND APPLICATIONS OF HIGHLY RELIABLE SYSTEMS)

專題名稱(英文): 基於陣列架構之人工智慧加速器系統單晶片之測試晶片(A Systolic-Array-Based AI Accelerator SoC Test Chip)

包裝形式: Package:40 S/B:2Pcs

追加顆數: 0Pcs + DieSort:16EA

晶片面積: 1.463*1.464 mm²

申請編號: U18-114C-E0043a

專題名稱(中文): 高可靠度系統之設計、測試與應用(DESIGN, TEST, AND APPLICATIONS OF HIGHLY RELIABLE SYSTEMS)

專題名稱(英文): 可反制功耗旁通道攻擊並具高度成本效益之物理不可複製功能電路設計與實現(Design and Implementation of Physically Unclonable Function (PUF) Circuit with High Cost-Effectiveness and Resistance to Power Side-Channel Attacks)

包裝形式: Package:40 S/B:2Pcs

追加顆數: 0Pcs + DieSort:16EA

晶片面積: 1.413*1.413 mm²

申請編號: U18-114C-E0044a

專題名稱(中文): 積體電路系統測試專題(null)

專題名稱(英文): 赫夫曼編碼(Huffman Coding)

包裝形式: Package:40 S/B:2Pcs

追加顆數: 0Pcs + DieSort:16EA

晶片面積: 1.413*1.413 mm²

申請編號: U18-114C-E0045a

專題名稱(中文): 積體電路系統測試專題(null)

專題名稱(英文): 赫夫曼編碼器(Huffman Coding)

包裝形式: Package:40 S/B:2Pcs

追加顆數: 0Pcs + DieSort:16EA

晶片面積: 1.313*1.313 mm²

申請編號: U18-114C-E0046

專題名稱(中文): 射頻積體電路設計(null)

專題名稱(英文): 應用於生理訊號感測之多頻帶雷達系統(Multi-band radar system applied to physiological signal sensing)

包裝形式: Package:N/A + DieSort:18EA

晶片面積: 1.314*1.185 mm²

申請編號: U18-114C-E0048

專題名稱(中文): 混和訊號積體電路設計專題(null)

專題名稱(英文): 高動態範圍電流式頻率輸出之低功耗三合一感測器前端電路(A low-power high dynamic range triple-function sensor front-end circuit)

包裝形式: Package:40 S/B:2Pcs

追加顆數:0Pcs + DieSort:16EA

晶片面積: 1.499*1.499 mm²

申請編號: U18-114C-E0049a

專題名稱(中文): 高可靠度系統之設計、測試與應用(null)

專題名稱(英文): LED 顯示控制器(LED Display Controller)

包裝形式: Package:40 S/B:2Pcs

追加顆數:0Pcs + DieSort:16EA

晶片面積: 1.493*1.493 mm²

申請編號: U18-114C-E0050

專題名稱(中文): 微系統有限元素法(null)

專題名稱(英文): 二階放大器(Twostageamp)

包裝形式: Package:18 S/B:2Pcs

追加顆數:0Pcs + DieSort:16EA

晶片面積: 0.583*0.571 mm²

申請編號: U18-114C-E0051

專題名稱(中文): CMOS 射頻電路設計專題(null)

專題名稱(英文): 1GHZ 電壓控制振盪器 (A 1GHz Voltage Control Oscillator)

包裝形式: Package:18 S/B:2Pcs

追加顆數:0Pcs + DieSort:16EA

晶片面積: 0.971*0.710 mm²

申請編號: U18-114C-E0052a

專題名稱(中文): 高可靠度系統之設計、測試與應用(null)

專題名稱(英文): LED 控制電路(LEDDC)

包裝形式: Package:40 S/B:2Pcs

追加顆數:0Pcs + DieSort:16EA

晶片面積: 1.413*1.413 mm²

申請編號: U18-114C-E0053m

專題名稱(中文): VLSI 電路設計實習(二)(null)

專題名稱(英文): 一具有數位輸出之 MEMS 讀出電路(A MEMS Readout Circuit with Digital Output)

包裝形式: Package:28 S/B:2Pcs

追加顆數:0Pcs + DieSort:16EA

晶片面積: 1.182*1.351 mm²

申請編號: U18-114C-E0054

專題名稱(中文): 微系統有限元素法(null)

專題名稱(英文): 二階放大器(Twostageamp)

包裝形式: Package:18 S/B:2Pcs

追加顆數:0Pcs + DieSort:16EA

晶片面積: 0.558*0.555 mm²

申請編號: U18-114C-E0055

專題名稱(中文): 特殊應用積體電路概論(null)

專題名稱(英文): 自振時脈數位式二元樹搜尋法低壓降線性穩壓器(Self-Oscillating Clock Digital Binary Search Low Dropout Linear Regulator)

包裝形式: Package:40 S/B:2Pcs

追加顆數:0Pcs + DieSort:16EA

晶片面積: 1.169*1.165 mm²

申請編號: U18-114C-E0060

專題名稱(中文): 特殊應用積體電路概論(null)

專題名稱(英文): 應用於植入式醫療裝置之 1V 低功耗鎖相迴路之設計與實作(Design and Implementation of a 1V Low-Power Phase-Locked Loop for Implantable Biomedical Devices)

包裝形式: Package:24 S/B:2Pcs

追加顆數:0Pcs + DieSort:16EA

晶片面積: 0.940*0.940 mm²

申請編號: U18-114C-E0062

專題名稱(中文): 積體電路佈局專題(null)

專題名稱(英文): 基於最佳化等效旁通技術的低功耗平行乘法器(A Low-power Parallel Multiplier Based on Optimized-Equal-Bypassing-Technique)

包裝形式: Package:40 S/B:2Pcs

追加顆數:0Pcs + DieSort:16EA

晶片面積: 1.469*1.469 mm²

申請編號: U18-114C-E0063

專題名稱(中文): 積體電路佈局專題(null)

專題名稱(英文): 基於最佳化等效旁通技術的低功耗平行乘法器(A Low-power Parallel Multiplier Based on Optimized-Equal-Bypassing-Technique)

包裝形式: Package:40 S/B:2Pcs

追加顆數:0Pcs + DieSort:16EA

晶片面積: 1.469*1.469 mm²

申請編號: U18-114C-E0064

專題名稱(中文): 積體電路佈局專題(INDEPENDENT STUDIES IN IC LAYOUT)

專題名稱(英文): 4.44 GHz 除頻器(A 4.44 GHz Divider)

包裝形式: Package:18 S/B:2Pcs

追加顆數:0Pcs + DieSort:16EA

晶片面積: 0.740*0.634 mm²

申請編號: U18-114C-E0065

專題名稱(中文): 系統晶片實作專題(null)

專題名稱(英文): 1.8 V-to-1.5 V 低壓差線性穩壓器(1.8 V-to-1.5 V Low-Dropout Regulator)

包裝形式: Package:18 S/B:2Pcs

追加顆數:0Pcs + DieSort:16EA

晶片面積: 0.988*1.067 mm²

申請編號: U18-114C-E0066

專題名稱(中文): 特殊應用積體電路概論(null)

專題名稱(英文): 具二進位權重式電晶體列陣之無外部電容 數位低壓降線性穩壓器(A Capacitor-Free Digital Low-Dropout Regulator Based on Binary-Weighted PMOS Array)

包裝形式: Package:40 S/B:2Pcs

追加顆數:0Pcs + DieSort:16EA

晶片面積: 1.165*1.165 mm²

申請編號: U18-114C-E0067

專題名稱(中文): 微系統有限元素法(null)

專題名稱(英文): 二階放大器(Twostageamp)

包裝形式: Package:18 S/B:2Pcs

追加顆數:0Pcs + DieSort:16EA

晶片面積: 0.622*0.597 mm²

申請編號: U18-114C-E0068

專題名稱(中文): 積體電路佈局專題(SPECIAL TOPICS IN IC LAYOUT)

專題名稱(英文): 基於最佳化等效旁通技術的低功耗平行乘法器(A Low-power Parallel Multiplier Based on Optimized-Equal-Bypassing-Technique)

包裝形式: Package:40 S/B:2Pcs

追加顆數:0Pcs + DieSort:16EA

晶片面積: 1.469*1.469 mm²

申請編號: U18-114C-E0069

專題名稱(中文): 超大型積體電路設計(null)

專題名稱(英文): 具雙端環形振盪器與 1.2GHz 輸出頻率之充電泵式鎖相迴路設計與實現
(Design and Implementation of 1.2GHz Output Frequency Charge-Pump Phase-Locked Loop with a Differential Ring Oscillator)

包裝形式: Package:40 S/B:2Pcs

追加顆數:0Pcs + DieSort:16EA

晶片面積: 1.143*1.143 mm²

申請編號: U18-114C-E0070

專題名稱(中文): 積體電路佈局專題(null)

專題名稱(英文): 基於最佳化等效旁通技術的低功耗平行乘法器(A Low-power Parallel Multiplier Based on Optimized-Equal-Bypassing-Technique)

包裝形式: Package:40 S/B:2Pcs

追加顆數:0Pcs + DieSort:16EA

晶片面積: 1.469*1.469 mm²

申請編號: U18-114C-E0071

專題名稱(中文): 積體電路佈局專題(SPECIAL TOPICS IN IC LAYOUT)

專題名稱(英文): 改良型 Booth 乘法器(Modified Booth Multiplier)

包裝形式: Package:40 S/B:2Pcs

追加顆數:0Pcs + DieSort:16EA

晶片面積: 1.469*1.469 mm²

申請編號: U18-114C-E0072

專題名稱(中文): 積體電路佈局專題(null)

專題名稱(英文): 基於最佳化等效旁通技術之低功耗並行乘法器(A Low-power Parallel Multiplier Based on Optimized-Equal-Bypassing-Technique)

包裝形式: Package:40 S/B:2Pcs

追加顆數:0Pcs + DieSort:16EA

晶片面積: 1.469*1.469 mm²

申請編號: U18-114C-E0073+m

專題名稱(中文): 微機電系統概論(null)

專題名稱(英文): 低電壓 CMOS-MEMS 梳齒式驅動器於精密微動應用之設計與最佳化
(Design and Optimization of a Low-Voltage CMOS-MEMS Comb-Drive Actuator for Precision Micro-Motion Applications)

包裝形式: Package:N/A + DieSort:18EA

晶片面積: 1.100*1.100 mm²

申請編號: U18-114C-E0074

專題名稱(中文): 射頻積體電路設計(null)

專題名稱(英文): 開關電容類比濾波器設計(Analog Switched-Capacitor Filter IC Design)

包裝形式: Package:N/A + DieSort:18EA

晶片面積: 0.672*0.529 mm²

申請編號: U18-114C-E0075a

專題名稱(中文): 高可靠度系統之設計、測試與應用(DESIGN, TEST, AND APPLICATIONS OF HIGHLY RELIABLE SYSTEMS)

專題名稱(英文): ApproxSoC: 具錯誤容忍的近似人工智慧加速器測試晶片(ApproxSoC: A Fault-Tolerant Approximate AI Accelerator Test Chip)

包裝形式: Package:40 S/B:2Pcs

追加顆數:0Pcs + DieSort:16EA

晶片面積: 1.463*1.464 mm²

申請編號: U18-114C-E0076+m

專題名稱(中文): 微機電系統概論(null)

專題名稱(英文): 用於拍翼式氣動量測之真空電容式梳齒驅動混合型 MEMS 感測器 (Vacuum-Capacitive Comb-Drive MEMS Sensor for Flapping-Wing Pressure Measurement)

包裝形式: Package:N/A + DieSort:18EA

晶片面積: 1.250*1.095 mm²

申請編號: U18-114C-E0077a

專題名稱(中文): 積體電路系統測試專題(null)

專題名稱(英文): 接縫裁剪引擎(Seam Carving Engine)

包裝形式: Package:40 S/B:2Pcs

追加顆數:0Pcs + DieSort:16EA

晶片面積: 1.500*1.500 mm²

申請編號: U18-114C-E0078a

專題名稱(中文): 高可靠度系統之設計、測試與應用(null)

專題名稱(英文): 可測及可靠圖像卷積電路設計(Testable and Reliable Image Convolutional Circuit Design)

包裝形式: Package:40 S/B:2Pcs

追加顆數:0Pcs + DieSort:16EA

晶片面積: 1.463*1.464 mm²

申請編號: U18-114C-E0079m

專題名稱(中文): 電子學實習(一)(null)

專題名稱(英文): 微機電開關測試元件(Mems Switch testkey)

包裝形式: Package:N/A + DieSort:18EA

晶片面積: 1.304*1.463 mm²

申請編號: U18-114C-E0080m

專題名稱(中文): 碩士論文(null)

專題名稱(英文): 微機電 z 軸開關測試元件(Mems z axis Switch testkey)

包裝形式: Package:N/A + DieSort:18EA

晶片面積: 1.426*1.268 mm²

申請編號: U18-114C-E0082

專題名稱(中文): 實作專題二(null)

專題名稱(英文): 採用自適應體驅動前饋技術且具有高電源抑制比之無電容低壓降穩壓器(High PSR capacitor-less LDO with adaptive bulk-driven feedforward technique)

包裝形式: Package:28 S/B:2Pcs

追加顆數:0Pcs + DieSort:16EA

晶片面積: 0.971*0.848 mm²

申請編號: U18-114C-E0083

專題名稱(中文): 實作專題二(null)

專題名稱(英文): 雙通道可變增益差動低雜訊放大器於心電訊號之設計與實現(Design and Implementation of a Dual-Channel Variable-Gain Differential Low-Noise Amplifier for ECG Signals)

包裝形式: Package:24 S/B:2Pcs

追加顆數:0Pcs + DieSort:16EA

晶片面積: 0.818*0.818 mm²

申請編號: U18-114C-E0084

專題名稱(中文): 實作專題二(null)

專題名稱(英文): 具旁路視窗之 10 位元 10kHz 低功耗 SAR ADC(應用於生醫訊號) (A 10bits 10kHz Low-Power SAR ADC with Bypass Window using for Biomedical Application)

包裝形式: Package:24 S/B:2Pcs

追加顆數:0Pcs + DieSort:16EA

晶片面積: 1.380*1.130 mm²

申請編號: U18-114C-E0085m

專題名稱(中文): 微感測器與微致動器(Micro Sensors and Actuators)

專題名稱(英文): 微機電系統人字形熱致動器(MEMS chevron-type thermal actuator)

包裝形式: Package:40 S/B:2Pcs

追加顆數:0Pcs + DieSort:16EA

晶片面積: 1.500*1.500 mm²

二、不下線名單:

本梯次無

以下無資料